

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0213U005350

Державний реєстраційний номер: 0111U001005

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-04-2013

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Дослідити процеси осадження високодіелектричних шарів SiC та розробити оптимальні умови для захисту електронних приладів із SiC. Дослідити природу та концентрацію власних носіїв заряду в плівках

Початок етапу: 01.2012

Закінчення етапу: 12.2012

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут монокристалів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (057)340-93-43

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 816.16

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Низькотемпературне одержання плівок карбіду кремнію з заданими властивостями для електроніки і оптоелектроніки

Назва роботи англійською:

Low-temperature obtaining of silicon carbide films with preset properties meant for electronics and optoelectronics

Реферат українською:

Досліджено виникнення фотовольтаїчного ефекту (ФВЕ) в гетеропереході, який має набагато більш складний механізм на відміну від гомогенного рп-переходу. Досліджено параметри ВАХ мезо-структур кремнієвих високовольтних НВЧ рп діодів з захищеною поверхнею в умовах впливу вологості. Показано, що після впливу вологості (95+/-3)% на протязі 60 годин при температурі +60гр.С параметри діодів (опір, ємність та пробивна напруга) не змінюються

Реферат англійською:

The onset of photovoltaic effect in the heterotransition which mechanism is much more complex in comparison with that of homogeneous transition, was investigated. Studied are the I-V parameters of the mesostructures of high-voltage SHF silicon pin diodes with protected surface under the influence of moisture. The diode parameters (resistance, capacitance and breakdown voltage) were shown to be unchanged after the action of (95+/-3)% humidity during 60 hours at 60 degrees Celsius.

Індекс УДК: 621.315.616.95/.96; 621.315.616.97; 621.315.616-419, [539.216:546.261]+621.384

Коди тематичних рубрик: 47.09.53

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Семенов Олександр Володимирович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1.Semenov A.V., Puzikov V.M. et al.Peculiarities of sic films deposition from ions beams on substrates with gradient heating, Poverhost, Rentgeovskie, Rentgenovskie, Sinkhrotronnye i Neitronnee Issledovaniya, №2 (2010) p.2 .

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Пузіков Вячеслав Михайлович

Перелік осіб-виконавців

Лопін Олександр Володимирович

Пузіков Вячеслав Михайлович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

